

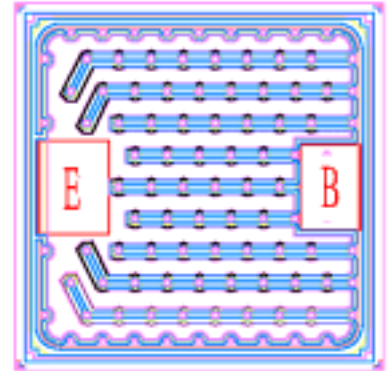


669A 晶体管芯片说明书

■ 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
 芯片代码：C117AJ-00
 芯片厚度： $240 \pm 20 \mu\text{m}$
 管芯尺寸： $1170 \times 1170 \mu\text{m}^2$
 焊位尺寸：B 极 $272 \times 192 \mu\text{m}^2$ ；E 极 $226 \times 298 \mu\text{m}^2$
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：2SD669A，HS669A，H669A

■ 管芯示意图

■ 极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$) (TO-126、TO-126ML)

T_{stg} ——贮存温度.....-55~150
 T_j ——结温.....150
 P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25^\circ\text{C}$).....20W
 P_C ——集电极功率耗散 ($T_A=25^\circ\text{C}$).....1W
 V_{CBO} ——集电极—基极电压.....180V
 V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....160V
 V_{EBO} ——发射极—基极电压.....5V
 I_C ——集电极电流.....1.5A

■ 电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$) (TO-126、TO-126ML)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	180			V	$I_C=1\text{mA}$ ， $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	160			V	$I_C=10\text{mA}$ ， $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	$I_E=1\text{mA}$ ， $I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			10	μA	$V_{\text{CB}}=160\text{V}$ ， $I_E=0$
h_{FE}	直流电流增益	60		300		$V_{\text{CE}}=5\text{V}$ ， $I_C=150\text{mA}$
		30				$V_{\text{CE}}=5\text{V}$ ， $I_C=500\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压			1	V	$I_C=500\text{mA}$ ， $I_B=50\text{mA}$
$V_{\text{BE(on)}}$	基极—发射极电压			1.5	V	$V_{\text{CE}}=5\text{V}$ ， $I_C=150\text{mA}$
f_T	特征频率		140		MHz	$V_{\text{CE}}=5\text{V}$ ， $I_C=150\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		14		pF	$V_{\text{CB}}=10\text{V}$ ， $I_E=0$ ， $f=1\text{MHz}$